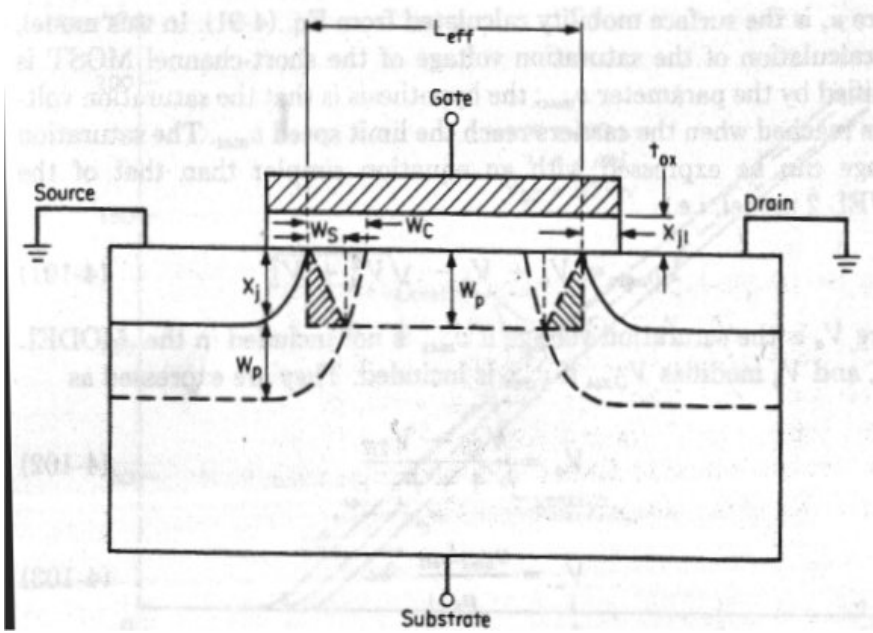


$$X_D = \sqrt{\frac{2\epsilon_s}{qN_A}} \quad (5.92)$$

şeklinde gösterilir.

$W_c$ , kaynak-taban jonksiyonunun silindirik fakirleşmiş bölgesinin kalınlığıdır. Bu durumda (5.93) ampirik bağıntısı bulunur.

$$\frac{W_c}{X_j} = 0.0831353 + 0.8013929 \frac{W_p}{X_j} - 0.0111077 \left( \frac{W_p}{X_j} \right)^2 \quad (5.93)$$



Şekil-5.25. Kanal sınırlarındaki fakirleşmiş bölgeler tarafından azaltılmış taban yükü  $Q_B$ 'nin geometrik hesaplanması

### Kanal genişliğinin eşik gerilimi üzerine etkisi

$F_n$  dar kanal etkisini gösterir ve MOS2'de olduğu gibi

$$F_n = \frac{\epsilon_s \delta \pi}{4C'_{ox} W} \quad (5.94)$$